



## ■ IGBTモールドタイプ Molded Package Type IGBTs

電子レンジ用モールドタイプ

Molded package types, such as microwave ovens

形式 Device type	V <sub>CEs</sub>	V <sub>GEs</sub>	I <sub>c</sub> Cont.	P <sub>c</sub>	V <sub>CE(sat)</sub> (V <sub>GE</sub> =15V)		t <sub>f</sub> μsec.	R <sub>th(j-c)</sub> °C/W	パッケージ Package	質量 Net mass Grams
	Volts	Volts	Amps.	Watts	Max. Volts	I <sub>c</sub> Amps.				
1MBH60D-090A	900	±20	60	260	3.2	60	0.8	0.481	TO-3PL	9.5
1MBH65D-090A	900	±20	65	300	5.54	60	0.77	0.417	TO-3PL	9.5

## ■ IGBT用高速ダイオード Fast Recovery Diodes for IGBT

モールドパッケージ FRD

Molded FRD

形式 Device type	V <sub>RRM</sub>	I <sub>FM</sub>	V <sub>F</sub>	t <sub>rr</sub> Switching time (Max.) (μsec.) di/dt=100A/μs 70% recovery	パッケージ Package	質量 Net mass Grams
	Volts	Amps.	Volts			
ERW01-060	600	5(T <sub>C</sub> =118°C)	3 (I <sub>F</sub> = 5A)	0.3 (I <sub>F</sub> = 5A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW02-060	600	10(T <sub>C</sub> =100°C)	3 (I <sub>F</sub> =10A)	0.3 (I <sub>F</sub> =10A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW03-060	600	15(T <sub>C</sub> =92°C)	3 (I <sub>F</sub> =15A)	0.3 (I <sub>F</sub> =15A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW04-060	600	20(T <sub>C</sub> =91°C)	3 (I <sub>F</sub> =20A)	0.3 (I <sub>F</sub> =20A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW05-060	600	30(T <sub>C</sub> =81°C)	3 (I <sub>F</sub> =30A)	0.3 (I <sub>F</sub> =30A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW06-060	600	50(T <sub>C</sub> =77°C)	3 (I <sub>F</sub> =50A)	0.3 (I <sub>F</sub> =50A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-3P(single)	5.5
ERW07-120	1200	2.5(T <sub>C</sub> =129°C)	3 (I <sub>F</sub> = 2.5A)	0.35 (I <sub>F</sub> = 2.5A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW08-120	1200	5(T <sub>C</sub> =127°C)	3 (I <sub>F</sub> = 5A)	0.35 (I <sub>F</sub> = 5A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW09-120	1200	8(T <sub>C</sub> =124°C)	3 (I <sub>F</sub> = 8A)	0.35 (I <sub>F</sub> = 8A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW10-120	1200	10(T <sub>C</sub> =123°C)	3 (I <sub>F</sub> =10A)	0.35 (I <sub>F</sub> =10A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-220AB(single)	2.0
ERW11-120	1200	15(T <sub>C</sub> =122°C)	3 (I <sub>F</sub> =15A)	0.35 (I <sub>F</sub> =15A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-3P(single)	5.5
ERW12-120	1200	25(T <sub>C</sub> =113°C)	3 (I <sub>F</sub> =25A)	0.35 (I <sub>F</sub> =25A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-3P(single)	5.5
ERW13-060	600	50(T <sub>C</sub> =90°C)	3 (I <sub>F</sub> =50A)	0.3 (I <sub>F</sub> =50A, V <sub>R</sub> =200V)	TO-3PL	9.5

### 記号 Letter symbols

V <sub>CEs</sub> :	コレクタ・エミッタ間電圧	Collector-to-emitter rated voltage (Gate-to-emitter short-circuited)
V <sub>GEs</sub> :	ゲート・エミッタ間電圧	Gate-to-emitter rated voltage (Collector-to-emitter short-circuited)
I <sub>c</sub> :	コレクタ電流	Rated collector current
P <sub>c</sub> :	最大損失	Maximum power dissipation
V <sub>CE(sat)</sub> :	コレクタ・エミッタ飽和電圧	Collector-to-emitter saturation voltage
t <sub>on</sub> :	ターンオン時間	Turn-on time
t <sub>off</sub> :	ターンオフ時間	Turn-off time
t <sub>f</sub> :	立上り時間	Fall time